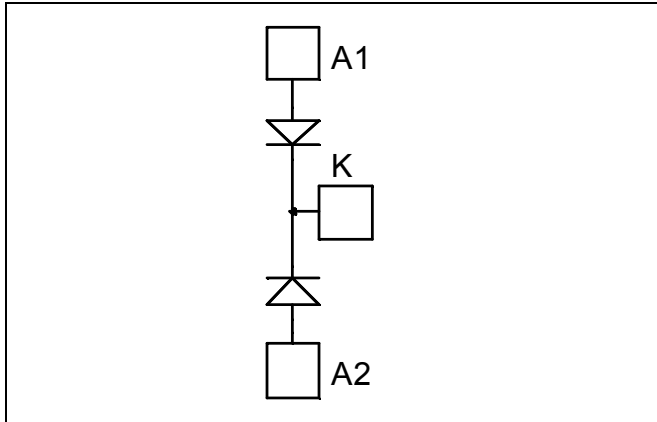


Dual Common Cathode diodes Power Module

$V_{RRM} = 600V$
 $I_C = 400A @ T_c = 80^{\circ}C$



Application

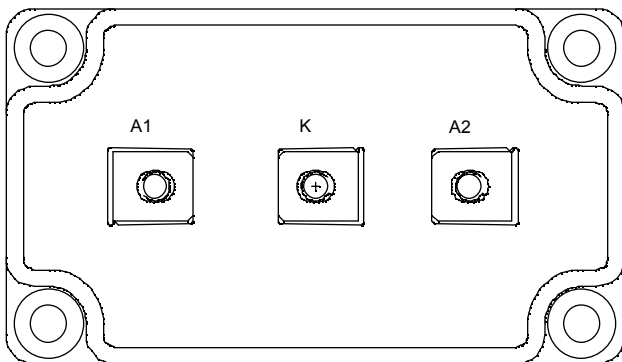
- Uninterruptible Power Supply (UPS)
- Induction heating
- Welding equipment
- High speed rectifiers

Features

- Ultra fast recovery times
- Soft recovery characteristics
- High blocking voltage
- High current
- Low leakage current
- Very low stray inductance
 - Symmetrical design
 - M5 power connectors
- High level of integration

Benefits

- Outstanding performance at high frequency operation
- Low losses
- Low noise switching
- Direct mounting to heatsink (isolated package)
- Low junction to case thermal resistance
- RoHS Compliant



Absolute maximum ratings

Symbol	Parameter	Max ratings	Unit
V_R	Maximum DC reverse Voltage	600	V
V_{RRM}	Maximum Peak Repetitive Reverse Voltage		
$I_{F(AV)}$	Maximum Average Forward Current	Duty cycle = 50% $T_C = 25^{\circ}C$	500
		$T_C = 80^{\circ}C$	400
$I_{F(RMS)}$	RMS Forward Current	Duty cycle = 50% $T_C = 45^{\circ}C$	500
I_{FSM}	Non-Repetitive Forward Surge Current	8.3ms $T_C = 45^{\circ}C$	3000

CAUTION: These Devices are sensitive to Electrostatic Discharge. Proper Handling Procedures Should Be Followed. See application note APT0502 on www.microsemi.com

All ratings @ $T_j = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified

Electrical Characteristics

<i>Symbol</i>	<i>Characteristic</i>	<i>Test Conditions</i>		<i>Min</i>	<i>Typ</i>	<i>Max</i>	<i>Unit</i>
V_F	Diode Forward Voltage	$I_F = 400\text{A}$			1.6	2.0	V
		$I_F = 800\text{A}$			2.0		
		$I_F = 400\text{A}$	$T_j = 125^\circ\text{C}$		1.3		
I_{RM}	Maximum Reverse Leakage Current	$V_R = 600\text{V}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$			750	μA
			$T_j = 125^\circ\text{C}$			1000	
C_T	Junction Capacitance	$V_R = 600\text{V}$			760		pF

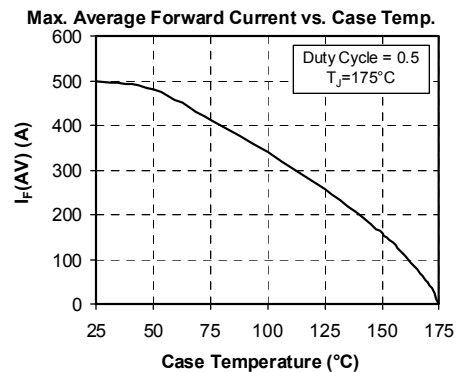
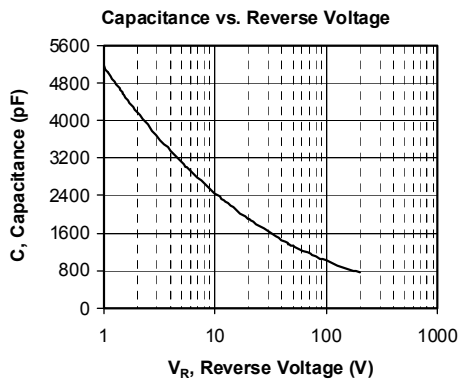
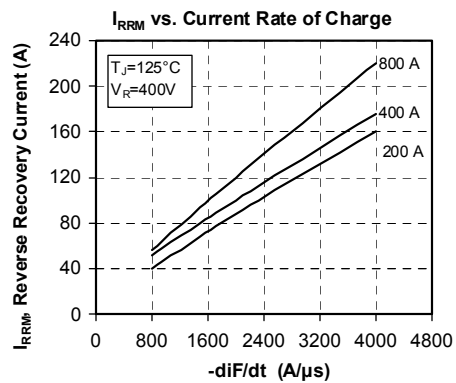
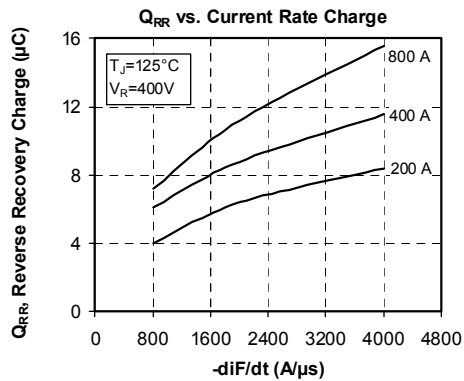
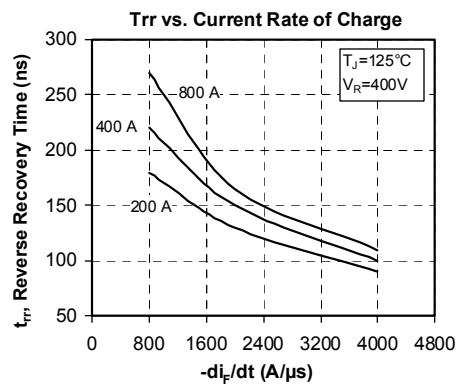
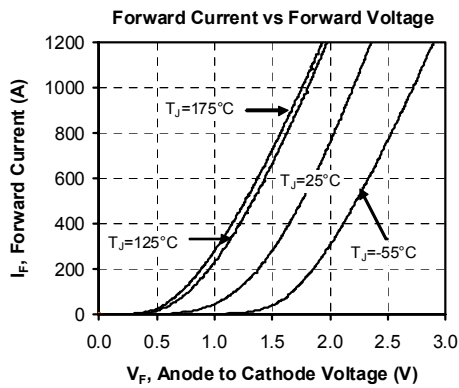
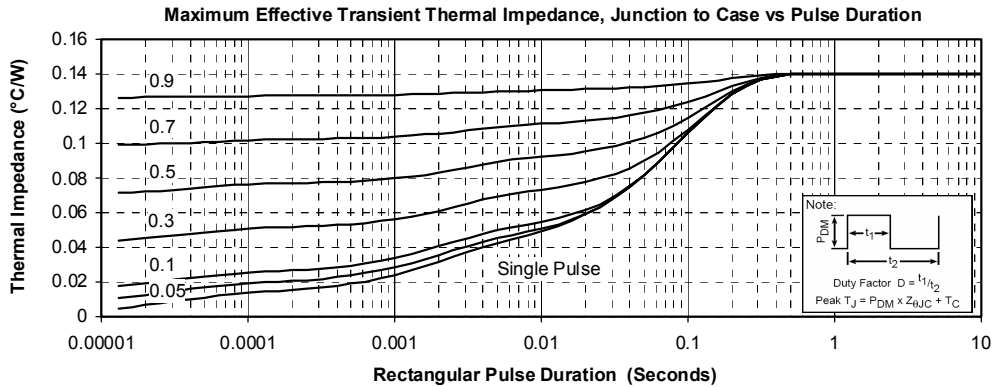
Dynamic Characteristics

<i>Symbol</i>	<i>Characteristic</i>	<i>Test Conditions</i>		<i>Min</i>	<i>Typ</i>	<i>Max</i>	<i>Unit</i>
t_{rr}	Reverse Recovery Time	$I_F = 1\text{A}, V_R = 30\text{V}$ $di/dt = 400\text{A}/\mu\text{s}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$		34		ns
t_{rr}	Reverse Recovery Time	$I_F = 400\text{A}$ $V_R = 400\text{V}$ $di/dt = 800\text{A}/\mu\text{s}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$		160		ns
			$T_j = 125^\circ\text{C}$		220		
Q_{rr}	Reverse Recovery Charge		$T_j = 25^\circ\text{C}$		1.16		μC
			$T_j = 125^\circ\text{C}$		6.12		
I_{RRM}	Reverse Recovery Current		$T_j = 25^\circ\text{C}$		20		A
			$T_j = 125^\circ\text{C}$		52		
t_{rr}	Reverse Recovery Time	$I_F = 400\text{A}$ $V_R = 400\text{V}$ $di/dt = 4000\text{A}/\mu\text{s}$	$T_j = 125^\circ\text{C}$		100		ns
Q_{rr}	Reverse Recovery Charge				11.6		μC
I_{RRM}	Reverse Recovery Current				176		A

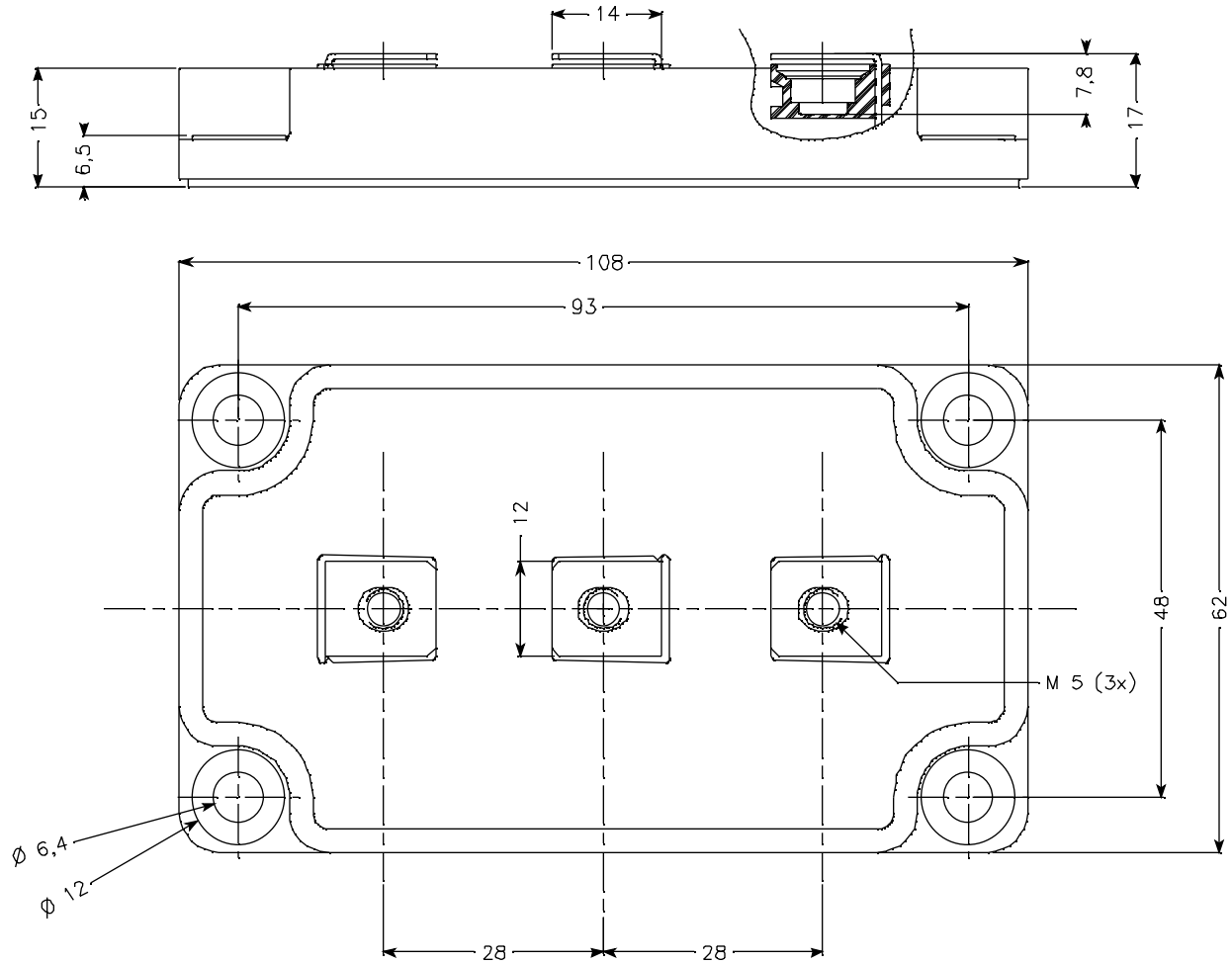
Thermal and package characteristics

<i>Symbol</i>	<i>Characteristic</i>	<i>Min</i>	<i>Typ</i>	<i>Max</i>	<i>Unit</i>	
R_{thJC}	Junction to Case Thermal Resistance			0.14	$^\circ\text{C}/\text{W}$	
V_{ISOL}	RMS Isolation Voltage, any terminal to case $t = 1\text{ min}$, $I_{isol} < 1\text{mA}$, 50/60Hz	2500			V	
T_j	Operating junction temperature range	-40		175	$^\circ\text{C}$	
T_{STG}	Storage Temperature Range	-40		125		
T_C	Operating Case Temperature	-40		100		
Torque	Mounting torque	To heatsink	M6	3	5	N.m
		For terminals	M5	2	3.5	
Wt	Package Weight			280	g	

Typical Performance Curve



SP6 Package outline (dimensions in mm)



Microsemi reserves the right to change, without notice, the specifications and information contained herein

Microsemi's products are covered by one or more of U.S. patents 4,895,810 5,045,903 5,089,434 5,182,234 5,019,522 5,262,336 6,503,786 5,256,583 4,748,103 5,283,202 5,231,474 5,434,095 5,528,058 and foreign patents. U.S. and Foreign patents pending. All Rights Reserved.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9